

お客様各位

STR Japan 株式会社

第一回結晶成長解析セミナーの報告

弊社は、2014年6月20日（金）に、第一回結晶成長解析セミナーを開催いたしました。今回は、シリコンやサファイアだけでなく、SiC, GaN といったワイドバンドギャップ材料の、昨今の研究開発状況を踏まえた様々な結晶系でのシミュレーションの活用事例と最新の情報を提供する結晶成長解析セミナーの開催となりました。その後の懇親会では、広い分野の研究者の方々との交流がはかられました。

STR グループからは、本社ロシアより来日した CEO の Roman Talalaev や CTO の Vladimir Kalaev が参加し、開発が進められているシミュレーションの紹介、STR Japan からは製品を使用した最新の解析事例や新機能の紹介をいたしました。また、会場には、弊グループが学会で発表したポスターも掲示し、休み時間中も議論がなされておりました。

お客様からのご講演は、前述の結晶系でのバルクやエピそしてデバイスの結晶成長プロセスでの弊グループ製品を用いた、企業の研究開発や大学での教育用途での適用事例を研究成果と共にご発表いただきました。

本セミナーの目的としては、幅広い分野の研究者の方々にお集まりいただける場を通じて、お客様同士の交流と意見の交換から、お客様の今後のご研究のお役立てをする事と考えておりました。多くの方々にご参加いただき、活発な論議と交流がなされ、大盛況のうちに終わることが出来ました。

お忙しい中、講演いただきました講演者様、参加いただきました皆様、誠にありがとうございます。本セミナーが、皆様にとって有益な場となれば幸いです。今後とも、弊グループならびに弊社製品をご愛顧いただけますよう、よろしくお願いいたします。

日時：2014年6月20日（金） セミナー：12時～18時 懇親会：18時半～20時

会場：

- セミナー会場：横浜ビジネスパーク ウェストタワー7F 中会議室
(相鉄線天王町駅南口より徒歩5分もしくは JR 保土ヶ谷駅から無料シャトルバス)

<http://www.officenomura.jp/ybp/access/>

- 懇親会会場：横浜ビジネスパーク ウェストタワー1F Espresso Americano 横浜ビジネスパーク店

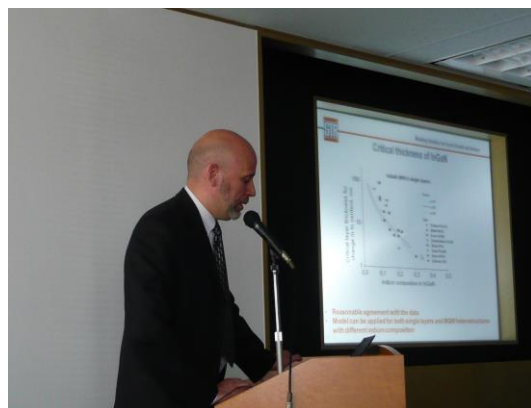
参加費：無料（懇親会参加費を含む）

セミナーでの講演演目

- 大形の VB 法サファイア結晶成長の種子付け界面形状と温度分布 宮川 千宏様 (信州大学)
- 融液着浸時にシリコン種結晶に発生する転位と熱応力との関係 日笠 光朗様 (グローバルウェーハズ・ジャパン)
- "Modeling of Cz crystal growth with horizontal MF using RANS, LES, and DNS approaches"
"Development of chemical models for silicon and sapphire crystal growth"
"Modeling of dislocation density and residual stresses in industrial crystal growth"
Vladimir Kalaev (STR Group)
- 窒化物半導体 LED 研究開発における SiLENSe 活用事例の紹介 竹内 哲也様 (名城大学)
- "New developments in modeling of MOCVD process for optical and electronic device manufacturing
- Modeling of evolution of stress, bowing, and structural defects in growth of III-nitride templates and heterostructures -"
Roman Talalaev (STR Group)
- 窒化物および III-V 族半導体エピタキシャル成長解析 向山 裕次 (STR Japan)
- デンソーにおける SiC 開発の取り組み 原 一都様 (デンソー)
- 高温ガス法による 4H-SiC 単結晶の高速成長 星乃 紀博様 (電力中央研究所)
- 冷却中のバルク SiC 単結晶内の転位と応力の解析 向山 裕次 (STR Japan)



STR Japan 株式会社
代表取締役 塚田 佳紀



STR Group, Inc.
CEO Roman Talalaev